

## ДАННЫЕ И ПУБЛИКАЦИИ

### НА ОППОНЕНТА ДИССЕРТАЦИИ ГАДЖИЕВА Т.М.

Заслуженного деятеля науки РФ ,

член-корреспондента Академии технических наук РФ.

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,

Каргина Н.И.

1. **ФИО оппонента:** Каргин Николай Иванович

2. **Ученая степень:** доктор технических наук, 02.00.04, Физическая химия.

3. **Список публикаций :**

1. J. C. V. Brito, N. V. Garonenko, K. S. Sukalin, T. F. Raichenok, S. A. Tikhomirov, V. A. Yankovskaya, N. I. Kargin. Luminescence of Eu<sup>3+</sup> in Yttrium–Alumina Films on Fused Silica Substrates // Journal of Applied Spectroscopy, 2017г., P.674-679.
2. I. Bolshakova, M. Bulavin, N. Kargin, Ya. Kost, T. Kuech, S. Kulikov, M. Radishevskiy, F. Shurygin, M. Strikhanov, I. Vasil'evskii. Metal Hall sensors for the new generation fusion reactors of DEMO scale // Nuclear Fusion, 2017, Vol. 57, No. 11, P. 116042.
3. N.I. Kargin, A.S. Gusev, S.M. Ryndya, A.D. Bakun, A.E. Ieshkin, A.A. Akovantseva, P.I. Misurkin, S.G. Lakeev, I. Matushchenko, S.F. Timashev . Visualization of supersmooth surfaces texture by the method of flicker-noise spectroscopy // Scientific Visualization, 2017, Vol. 9, No. 3. P. 28-41
4. S. A. Shostachenko, R.V. Zakharchenko, R. V. Ryzhuk, D.A. Kulyamina, N. I. Kargin. Low resistance Ti/Si/Ti/Al/Ni/Au ohmic contact for AlGaN/GaN HEMT // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2016 Vol. 10224. P. 1022403.
5. И.С. Василевский, А.Е. Кожанов, И.С. Еремин, О.С. Коленцова, Н.И. Каргин, Ю.Д. Сибирмовский. Особенности электронно-лучевой литографии для создания массивов магнитных наноэлементов с суб-50 нм разрешением // Ядерная физика и инжиниринг, 2015г. Т. 6. № 9-10. С. 521-526.
6. K. D. Vanyukhin, R. V. Zakharchenko, N. I. Kargin, M. V. Pashkov, L. A. Seidman. Processes during annealing of Ti–Al–Ni and Ti–Al–Ni–Au contact metallization systems // Russian Microelectronics, 2015, Vol. 44, No. 8. P. 564-568.

7. A.Ieshkin, Y.Ermakov, V.Chernysh, I.Ivanov, I.Kryukov, K.Alekseev, N.Kargin, Z.Insepov. Computer simulation and visualization of supersonic jet for gas cluster equipment // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2015, Vol. 795, P. 395-398.
8. E. A. Bondarenko, A. A. Skomorokhov, N. I. Kargin, A. S. Gusev. S. M. Ryndya. Study of the photoluminescence properties of crystal phosphors SrTiO<sub>3</sub>:Pr<sup>3+</sup> and SrTiO<sub>3</sub>:Pr<sup>3+</sup>, Al // Optics and Spectroscopy, 2015 Vol. 118, No. 5, P. 729-734.
9. K.S.Grishakov, V.F.Elesin, R.V.Ryzhuk, N.I.Kargin, S.V.Minnebaev. Effect of diamond and graphene heat spreaders on characteristics of AlGaIn/GaN HEMT // Physics Procedia, 2015. Vol. 72. P. 460-464.
10. S.M. Ryndya, N.I. Kargin, A.S. Gusev, E.P.Pavlova. PLD grown 3C-SiC thin films on Si: Morphology and structure. // Materials Science Forum, 2015г. Vol. 821-823. P. 213-216.
11. S. A. Shostachenko, K. D. Vanukhin, R. V. Ryzhuk, M. M. Maslov, K. P. Katin, R. V. Zakharchenko, S. V. Minnebaev, N. I. Kargin. Schottky-to-ohmic behavior in annealed Ti/Si/Ti/Al/Ni/Au on AlGaIn/GaN. // Physics Procedia, 2015 Vol. 72. P. 419-424.
12. A. N. Vinichenko, V. P. Gladkov, N. I. Kargin, M. N. Strikhanov, I. S. Vasilevskii. Increase of the electron mobility in HEMT heterostructures with composite spacers containing AlAs nanolayers // Semiconductors, 2014, Vol. 48, No. 12. P. 1619-1625 .
13. I. S. Vasilevskii, A. N. Vinichenko, M. M. Grekhov, V. P. Gladkov, N. I. Kargin, M. N. Strikhanov. Technology and electronic properties of PHEMT AlGaAs/Iny(z)Ga1-y(z)As/GaAs compositionally graded quantum wells // Semiconductors, 2014 Vol. 48, No. 9. P. 1226-1232.
14. A. S. Gusev, S. M. Ryndya, N. I. Kargin, D. V. Averyanov, E. P. Pavlova. Structural analysis of PLD grown 3C-SiC thin films on Si. // Journal of Surface Investigation, 2014 Vol. 8, No. 6. P. 1221-1229.
15. **K. D. Vanyukhin, R. V. Zakharchenko, N. I. Kargin, L. A. Seidman. Technological features of the formation of transparent conductive contacts of ITO film for LEDs based on gallium nitride. // Russian Microelectronics, 2014 Vol. 8, No. 43. P. 569-574**

**4. Полное наименование организации:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**5. Занимаемая должность:**

Директор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике

Профессор: Отделение нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике офиса образовательных программ, Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1. **Личный E-mail Каргина Н.И.:**

[krgn@yandex.ru](mailto:krgn@yandex.ru), [krgn@ya.ru](mailto:krgn@ya.ru).

**Ректор:**

доктор физико-математических наук, чл.-корр. академик РАО.

**Стриханов Михаил Николаевич**

**Почтовый адрес:**

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

**телефон:**

+7 (499) 324,+7 (495) 788-5699, доб. 9900

**Факс:**

+7 (499) 324-2111

**E-mail:** [rector@mephi.ru](mailto:rector@mephi.ru)